

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年11月15日 (2012.11.15)

【公表番号】特表2012-505551(P2012-505551A)

【公表日】平成24年3月1日 (2012.3.1)

【年通号数】公開・登録公報2012-009

【出願番号】特願2011-531175(P2011-531175)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/105 (2006.01)

H 0 1 L 27/10 (2006.01)

H 0 1 L 45/00 (2006.01)

H 0 1 L 49/00 (2006.01)

G 1 1 C 13/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/10 4 4 8

H 0 1 L 27/10 4 8 1

H 0 1 L 45/00 Z

H 0 1 L 49/00 Z

G 1 1 C 13/00 1 1 0 C

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月27日 (2012.9.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 5】

前記印加するステップは、印加電圧の大きさ、印加電圧の持続時間、または双方に少なくとも部分的に基づいて最終抵抗値を設定することを含むことを特徴とする請求項 2 4 に記載の方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 3 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3 0】

前記印加するステップは、印加電圧に応答して前記非結晶質シリコンナノ構造内に導電性フィラメントを形成することを含むことを特徴とする請求項 2 9 に記載の方法。